VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

			LDIET DEST	AI LIVI WESE		REC'D	3 0 JUN 2005				
Absen	der: INTERNAT	IONALE RECH	ERCHENBEHÖRDE		D0.	1	- DC	CT			
An:					PC	WIPC					
				SCHRIFT	LICHER B	BESCI	HEID DER	•			
	siehe Forn	nular PCT/ISA	/220 /.)	INTERNATIONALEN -							
		•	4/8	RECHERCHENBEHÖRDE							
			/	(Regel 43bis.1 PCT)							
	· ·			Absendedatum (Tag/Monat/Jahr) sie	he Formular PC	CT/ISA/2	10 (Blatt 2)				
Akten	zeichen des Anmeld	ters oder Anwalts		WEITERES VORGEHEN							
l .	e Formular PCT			siehe Punkt 2 unten							
Intern	ationales Aktenzeic	hen	Internationales Anmelde	datum <i>(Tag/Monat/Jahr)</i>	Prioritātsdatu	ım <i>(Tag/</i>	Monat(Jahr)	\neg			
PCT	/DE2005/000069	•	19.01.2005	22.01.2004							
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK H01L29/78, H01L29/12, H01L21/336, H01L29/775, H01L29/16, H01L51/30, H01L21/335											
,								_			
	Anmelder INFINEON TECHNOLOGIES AG										
Dieser Bescheid enthält Angaben zu folgenden Punkten:											
	☑ Feld Nr. I	Grundlage des	s Bescheids								
	⊠ Feld Nr. II Priorität										
	 Feld Nr. III Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische T\u00e4tigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit 										
	Feid Nr. IV MangeInde Einheitlichkeit der Erfindung						•				
-	🖾 Feld Nr. V	Begründete Fe	eststellung nach Regel	43bis.1(a)(i) hinsichtlic	h der Neuheit	t, der er	finderischen Tätigke	∍it			
		und der gewe	rblichen Anwendbarkeit	; Unterlagen und Erklä	rungen zur St	tützung	dieser Feststellung				
	Feld Nr. VI	Bestimmte an	geführte Unterlagen								
☐ Feld Nr. VII Bestimmte Mängel der Internationalen Anmeldung											
	☐ Feld Nr. VIII Bestlmmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung										
2.	WEITERES VO	RGEHEN					•				
Wird ein Antrag auf Internationale vorläufige Prüfung gestellt, so gilt dieser Bescheid als schriftlicher Bescheid der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde ("IPEA"); dies trifft nicht zu, wenn der Anmelder eine andere Behörde als diese als IPEA wählt und die gewählte IPEA dem Internationale Büro nach Regel 66.1 bis b) mitgeteilt hat, daß schriftliche Bescheide dieser Internationalen Recherchenbehörde nicht anerkannt werden.											
Wenn dieser Bescheid wie oben vorgesehen als schriftlicher Bescheid der IPEA glit, so wird der Anmelder aufgefordert, bei der IPEA vor Abiauf von 3 Monaten ab dem Tag, an dem das Formblatt PCT/ISA/220 abgesandt wurde oder vor Ablauf von 22 Monaten ab dem Prioritätsdatum, je nachdem, welche Frist später abläuft, eine schriftliche Stellungnahme und, wo dies angebracht ist, Änderungen einzureichen.											
	Weitere Optionen siehe Formblatt PCT/ISA/220.										
3.	Nähere Einzelheiten slehe die Anmerkungen zu Formblatt PCT/ISA/220.										

Name und Postanschrift der mit der internationalen Recherchenbehörde



Europäisches Patentamt • D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d Fax: +49 89 2399 - 4465

Bevollmächtigter Bediensteter

Berthold, K

Tel. +49 89 2399-2632



SCHRIFTLICHER BESCHEID DER INTERNATIONALEN RECHERCHEBEHÖRDE

Internationales Aktenzeichen PCT/DE2005/000069

	Feld N	r. 1	Grundlage des Bescheids				
1.	Hinsich erstellt	nsichtlich der Sprache ist der Bescheid auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache stellt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.					
	е	erste	escheid ist auf der Grundlage einer Übersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache Ilt worden, bei der es sich um die Sprache der Übersetzung handelt, die für die Zwecke der ationalen Recherche eingereicht worden ist (gemäß Regeln 12.3 und 23.1 b)).				
2.	Hinsich wurde worder	nsichtlich der Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz , die in der internationalen Anmeldung offenbart urde und für die beanspruchte Erfindung erforderlich ist, ist der Bescheid auf folgender Grundlage erstellt orden:					
	a. Art des Materials						
		Se	quenzprotokoll				
		Та	belle(n) zum Sequenzprotokoll				
	b. For	n de	es Materials				
		in :	schriftlicher Form				
		in	computerlesbarer Form				
	c. Zeitpunkt der Einreichung						
		in	der eingereichten internationalen Anmeldung enthalten				
		zu	sammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht				
		be	i der Behörde nachträglich für die Zwecke der Recherche eingereicht				
3.	ei o	nge der :	en mehr als eine Version oder Kopie eines Sequenzprotokolls und/oder einer dazugehörigen Tabelle reicht, so sind zusätzlich die erforderlichen Erklärungen, daß die Information in den nachgereichten zusätzlichen Kopien mit der Information in der Anmeldung in der eingereichten Fassung übereinstimmt nicht über sie hinausgeht, vorgelegt worden.				
4.	Zusät	zlich	e Bemerkungen:				
_	Feld i	dr. I	Priorität				
1.	R	ech ühe	ültigkeit des Prioritätsanspruchs wurde nicht in Betracht gezogen, da die Internationale erchenbehörde über keine Abschrift der früheren Anmeldung oder, falls benötigt, Übersetzung der ren Anmeldung verfügt. Dieser Bescheid wurde trotzdem unter der Annahme erstellt, dass der gebliche Zeitpunkt (Regeln 43 <i>bis.</i> 1 und 64.1) das beanspruchte Prioritätsdatum ist.				
2.	Р	☐ Dieser Bescheid ist ohne Berücksichtigung der beanspruchten Priorität erstellt worden, da sich der Prioritätsanspruch als ungültig erwiesen hat (Regeln 43 <i>bis</i> .1 und 64.1). Für die Zwecke dieses Bescheids gilt daher das vorstehend genannte internationale Anmeldedatum als das maßgebliche Datum.					
3.	Etwai	je z	usätzliche Bemerkungen:				

SCHRIFTLICHER BESCHEID DER INTERNATIONALEN RECHERCHEBEHÖRDE

Internationales Aktenzeichen PCT/DE2005/000069

Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Regel 43*bis*.1(a)(i) hinsichtlich der Neùheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Feststellung

Neuheit

Ja: Ansprüche 12-14,18,20-22

Nein: Ansprūche 1-11,15-17,19

Erfinderische Tätigkeit

Ja: Ansprüche 18

Nein: Ansprüche 1-17,19-22

Gewerbliche Anwendbarkeit

Ja: Ansprüche: 1-22

Nein: Ansprüche:

2. Unterlagen und Erklärungen:

siehe Beiblatt

Feld Nr. VI Bestimmte angeführte Unterlagen

 Bestimmte veröffentlichte Unterlagen (Regeln 43bis.1 und 70.10) und /oder

2. Nicht-schriftliche Offenbarungen (Regeln 43bis.1 und 70.9)

siehe Formular 210

Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Zur Klarheit der Patentansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Ansprüche in vollem Umfang durch die Beschreibung gestützt werden, ist folgendes zu bemerken:

siehe Beiblatt

Formblatt PCT/ISA/237 (Januar 2004)

Zu Punkt V.

- 1 Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen:
 - D1: US 2002/163079 A1 (AWANO YUJI) 7. November 2002 (2002-11-07)
 - D2: WO 00/51186 A (CLAWSON, JOSEPH, E., JR) 31. August 2000 (2000-08-31)
 - D3: US 2003/132461 A1 (ROESNER WOLFGANG ET AL) 17. Juli 2003 (2003-07-17)
 - D4: EP 0 452 950 A (HITACHI, LTD; HITACHI VLSI ENGINEERING CORPORATION) 23. Oktober 1991 (1991-10-23)
 - D5: US 2003/178617 A1 (APPENZELLER JOERG ET AL) 25. September 2003 (2003-09-25)
 - D6: WO 01/57917 A (XIDEX CORPORATION) 9.August.2001 (2001-08-09)
 - D7: US 5612563 A (MOTOROLA) 18.März.1997 (1997-03-18)
 - D8: WO 2004/040666 A (INFINEON) 13. Mai 2004 (2004-05-13)
 - D9: DE 10324752 A (INFINEON) 5.Januar 2005 (2005-01-05)

2 UNABHÄNGIGER ANSPRUCH 1

- 2.1 Die vorliegende Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT, weil der Gegenstand der Ansprüche 1 und 19 im Sinne von Artikel 33(2) PCT nicht neu ist.
 - Dokument D1 (siehe Figuren 13, 19-21 und dazugehörige Beschreibung) offenbart (die Verweise in Klammern beziehen sich auf dieses Dokument) einen Halbleiterleistungsschalter (vertikalen Feldeffektransistor der geeignet ist Leistung zu schalten, siehe Par. 120: "bundling a plurality of nanotubes improved current driving performance") mit Source (362), Drain (364) und Gate (372), parallele Nanodrähte (370) zwischen Source und Drain. Der Begriff "Drainkontakt" in Anspruch 19 impliziert keinen Unterschied, da die Elektrode 362 von D1, geeignet ist als Drainkontakt zu operieren.
- 2.2 Die vorliegende Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT, weil der Gegenstand des Anspruchs 1 im Sinne von Artikel 33(2) PCT nicht neu ist. Dokument D2 (siehe Figur 8 und dazugehörige Beschreibung) offenbart einen

Halbleiterleistungsschalter mit Gates G1, G2 und parallelen Nanodrähten (251) zwischen den Elektroden (258,257) welche Source- und Drainkontakte repräsentieren.

- 2.3 Die vorliegende Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT, weil der Gegenstand des Anspruchs 1 im Sinne von Artikel 33(2) PCT nicht neu ist. Dokument D3 (siehe Figur 1 und dazugehörige Beschreibung) offenbart einen Halbleiterleistungsschalter (der Ausdruck "Leistungschalter" definiert keinen Wert für die Leistung und somit umfasst er auch den FET von D3 welcher mehrere parallele Nanodrähte zeigt), Source (102), Drain (110), Gate (104) und parallele Nanodrähte (108).
- 2.4 Die vorliegende Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT, weil der Gegenstand des Anspruchs 1 im Sinne von Artikel 33(2) PCT nicht neu ist. Dokument D4 (siehe Figur 2 und dazugehörige Beschreibung) offenbart einen Halbleiterleistungschalter ("Leistungsschalter" beinhaltet die Anordnung von D4, da mehrere Drähte parallel verschaltet sind), parallele Nanodrähte (1), welche an ihren Enden verbunden sind und zwischen Source (5) und Drain (3) verbunden sind.
- 2.5 Die vorliegende Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT, weil der Gegenstand des Anspruchs 1 im Sinne von Artikel 33(2) PCT nicht neu ist. Dokument D5 (siehe Figur 5 und dazugehörige Beschreibung) offenbart einen vertikalen FET welcher parallel geschaltete Nanodrähte hat und somit geeignet ist Leistung zu schalten, Source, Drain (515, 501) und Nanodrähte (508).

ABHÄNGIGE ANSPRÜCHE:

Der allgemeine Wortlaut der Ansprüche 2-11,15-17,19 umfasst die Anordnungen des Standes der Technik (mangelnde Neuheit):

D1-D5 offenbaren isolierte und relativ lange Nanodrähte. Der allgemeine Wortlaut "Gatebänder" und "Gräben" in den Ansprüchen umfasst auch die Gatestreifenteile und die Gräben von D1,D3,D5. Dokumente D1 oder D3 offenbaren halbleitende Nanodrähte und Kohlenstoff Nanodrähte. D3 offenbart Si Nanodrähte.

Die Ansprüche 12-14,20-22 enthalten keine Merkmale, die die Erfordernisse des

PCT in Bezug auf erfinderische Tätigkeit erfüllen. Eine Mehrzahl von Gateelektroden ist aus D7 (siehe Figuren) oder D6 (siehe Figur 2) bekannt. Die Implementierung in die Anordnungen von D1 oder D3 fallen in die Kompetenz des Fachmannes.

Anspruch 18: Der Gegenstand des Anspruchs 18 (siehe Punkt VIII) ist aus dem Stand der Technik nicht bekannt, falls er mit Hilfe der Beschreibung als Methode interpretiert wird und die Anordnung der Gatebänder wie in Figur 7 dargestellt interpretiert wird.

Der Gegenstand, wie in Ansprüchen 1-22 definiert, ist offensichtlich gewerblich anwendbar.

Zu Punkt VI.

Die Dokumente D8 (Anmeldedatum: 29.10.2003, Veröffentlichungsdatum: 13.05.2004) und D9 (Anmeldedatum: 30.05.2003, Veröffentlichungsdatum: 05.01.2005) können im regionalen Verfahren relevant werden.

Zu Punkt VIII.

Die Kategorie von Anspruch 2 ist nicht klar, da er als Produktanspruch formuliert ist, aber Merkmale enthält die sich auf eine Verwendung beziehen ("anliegende Spannung"). Anspruch 18: "wellenförmige Gestalt" bezüglich einer Bandstruktur ist nicht klar, da die Mittel wie die "Band Gap Struktur" verändert wird nicht klar definiert sind und die Kategorie des Anspruchs nicht klar ist.